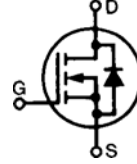


High Voltage Power MOSFETs

N-Channel Enhancement Mode
Avalanche Rated, High dv/dt

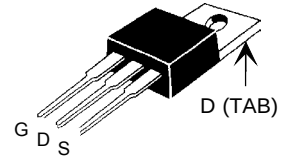
IXTA/IXTP 3N120
IXTA/IXTP 3N110

V_{DSS}	I_{D25}	$R_{DS(on)}$
1200 V	3 A	4.5 Ω
1100 V	3 A	4.0 Ω

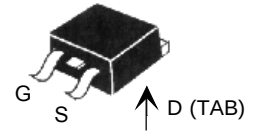


Symbol	Test Conditions	Maximum Ratings		
V_{DSS}	$T_J = 25^\circ\text{C}$ to 150°C	3N120 3N110	1200 1100	V V
V_{DGR}	$T_J = 25^\circ\text{C}$ to 150°C ; $R_{GS} = 1\text{ M}\Omega$	3N120 3N110	1200 1100	V V
V_{GS}	Continuous		± 20	V
V_{GSM}	Transient		± 30	V
I_{D25}	$T_C = 25^\circ\text{C}$		3	A
I_{DM}	$T_C = 25^\circ\text{C}$, pulse width limited by T_{JM}		12	A
I_{AR}	$T_C = 25^\circ\text{C}$		3	A
E_{AR}	$T_C = 25^\circ\text{C}$		20	mJ
E_{AS}			700	mJ
dv/dt	$I_S \leq I_{DM}$, $di/dt \leq 100\text{ A}/\mu\text{s}$, $V_{DD} \leq V_{DSS}$, $T_J \leq 150^\circ\text{C}$, $R_G = 2\text{ }\Omega$		5	V/ns
P_D	$T_C = 25^\circ\text{C}$		150	W
T_J			-55 to +150	$^\circ\text{C}$
T_{JM}			150	$^\circ\text{C}$
T_{stg}			-55 to +150	$^\circ\text{C}$
T_L	1.6 mm (0.063 in) from case for 10 s		300	$^\circ\text{C}$
M_d	Mounting torque (TO-220)		1.13/10	Nm/lb.in.
Weight	TO-220 TO-263		4 2	g g

TO-220 (IXTP)



TO-263 (IXTA)



G = Gate
S = Source

D = Drain
TAB = Drain

Features

- International standard packages
- Low $R_{DS(on)}$
- Rated for unclamped Inductive load Switching (UIS)
- Molding epoxies meet UL 94 V-0 flammability classification

Advantages

- Easy to mount
- Space savings
- High power density

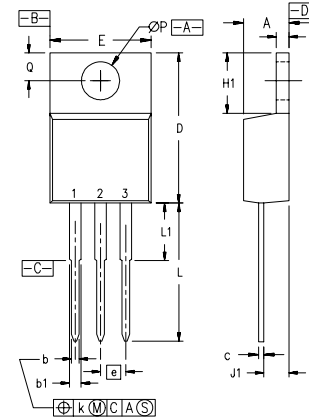
Symbol	Test Conditions	Characteristic Values (T _J = 25°C, unless otherwise specified)			
				min.	typ.
V _{DSS}	V _{GS} = 0 V, I _D = 1 mA	3N120	1200		V
		3N110	1100		V
V _{GS(th)}	V _{DS} = V _{GS} , I _D = 250 μA		2.5		4.5 V
I _{GSS}	V _{GS} = ±20 V _{DC} , V _{DS} = 0				±100 nA
I _{DSS}	V _{DS} = 0.8 V _{DSS}	T _J = 25°C			25 μA
	V _{GS} = 0 V	T _J = 125°C			1 mA
R _{DS(on)}	V _{GS} = 10 V, I _D = 0.5 I _{D25} Note 1	3N120			4.5 Ω
		3N110			4.0 Ω

Symbol	Test Conditions	Characteristic Values ($T_J = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified)		
		min.	typ.	max.
g_{fs}	$V_{DS} = 10\text{ V}; I_D = 0.5 \cdot I_{D25}$, Note 1	1.5	2.2	S
C_{iss}	$V_{GS} = 0\text{ V}, V_{DS} = 25\text{ V}, f = 1\text{ MHz}$	1050	1300	pF
C_{oss}		100	125	pF
C_{rss}		25	50	pF
$t_{d(on)}$	$V_{GS} = 10\text{ V}, V_{DS} = 0.5 \cdot V_{DSS}, I_D = 0.5 \cdot I_{D25}$ $R_G = 4.7\ \Omega$ (External),	17		ns
t_r		15		ns
$t_{d(off)}$		32		ns
t_f		18		ns
$Q_{g(on)}$	$V_{GS} = 10\text{ V}, V_{DS} = 0.5 \cdot V_{DSS}, I_D = 0.5 \cdot I_{D25}$	39		nC
Q_{gs}		9		nC
Q_{gd}		22		nC
R_{thJC}	(TO-220)		0.8	K/W
R_{thCK}		0.25		K/W

Source-Drain Diode		Characteristic Values ($T_J = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified)		
Symbol	Test Conditions	min.	typ.	max.
I_S	$V_{GS} = 0\text{ V}$			3 A
I_{SM}	Repetitive; pulse width limited by T_{JM}			12 A
V_{SD}	$I_F = I_S, V_{GS} = 0\text{ V}$, Note 1			1.5 V
t_{rr}	$I_F = I_S, -di/dt = 100\text{ A}/\mu\text{s}, V_R = 100\text{ V}$	700		ns

Notes: 1. Pulse test, $t \leq 300\ \mu\text{s}$, duty cycle $d \leq 2\%$

TO-220 (IXTP) Outline

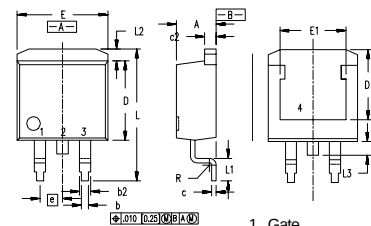


Pins: 1 - Gate
2 - Drain
3 - Source
4 - Drain
Bottom Side

SYM	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	.170	.190	4.32	4.83
b	.025	.040	0.64	1.02
b1	.045	.065	1.15	1.65
c	.014	.022	0.35	0.56
D	.580	.630	14.73	16.00
E	.390	.420	9.91	10.66
e	.100 BSC		2.54 BSC	
F	.045	.055	1.14	1.40
H1	.230	.270	5.85	6.85
J1	.090	.110	2.29	2.79
k	0	.015	0	0.38
L	.500	.550	12.70	13.97
L1	.110	.230	2.79	5.84
ØP	.139	.161	3.53	4.08
Q	.100	.125	2.54	3.18

NOTE: This drawing will meet all dimensions requirement of JEDEC outline TO-220 AB.

TO-263 (IXTA) Outline



1. Gate
2. Drain
3. Source
4. Drain
Bottom Side

Dim.	Millimeter		Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	4.06	4.83	.160	.190
A1	2.03	2.79	.080	.110
b	0.51	0.99	.020	.039
b2	1.14	1.40	.045	.055
c	0.46	0.74	.018	.029
c2	1.14	1.40	.045	.055
D	8.64	9.65	.340	.380
D1	7.11	8.13	.280	.320
E	9.65	10.29	.380	.405
E1	6.86	8.13	.270	.320
e	2.54	BSC	.100	BSC
L	14.61	15.88	.575	.625
L1	2.29	2.79	.090	.110
L2	1.02	1.40	.040	.055
L3	1.27	1.78	.050	.070
L4	0	0.38	0	.015
R	0.46	0.74	.018	.029

IXYS reserves the right to change limits, test conditions, and dimensions.

IXYS MOSFETs and IGBTs are covered by one or more of the following U.S. patents:

4,835,592	4,881,106	5,017,508	5,049,961	5,187,117	5,486,715	6,306,728B1
4,850,072	4,931,844	5,034,796	5,063,307	5,237,481	5,381,025	

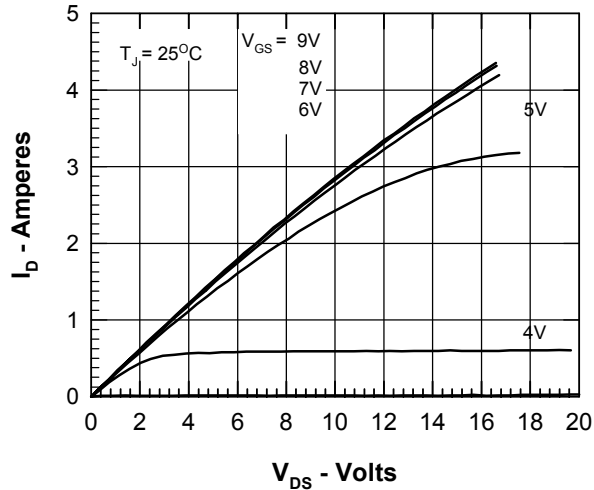


Fig.1 Output Characteristics @ $T_J = 25^\circ\text{C}$

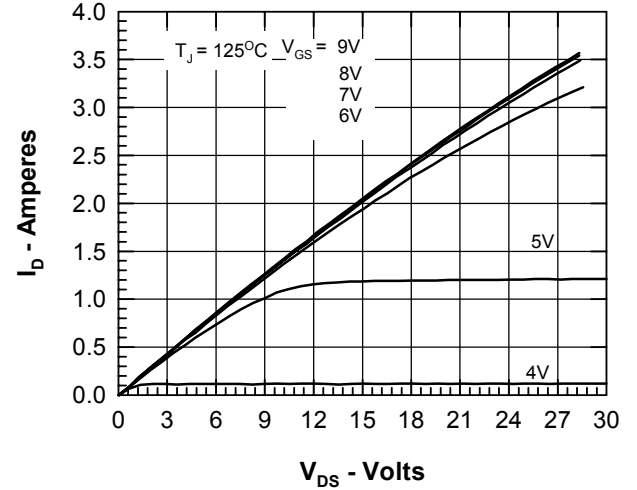


Fig. 2 Output Characteristics @ $T_J = 125^\circ\text{C}$

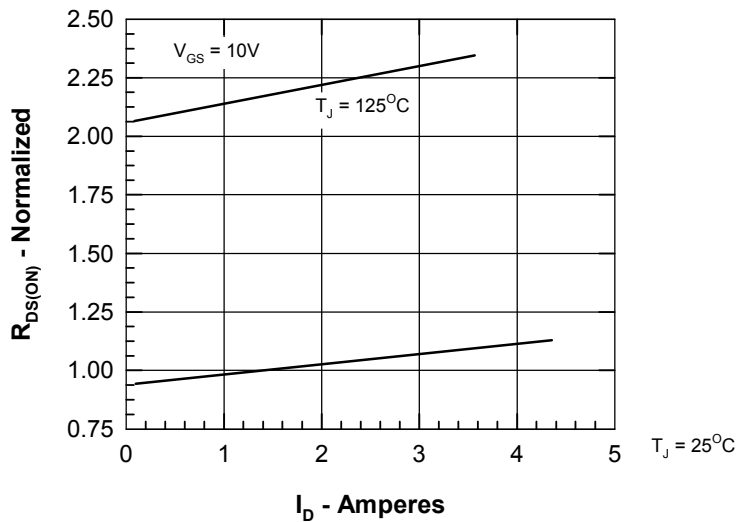


Fig. 3 $R_{DS(on)}$ vs. Drain Current

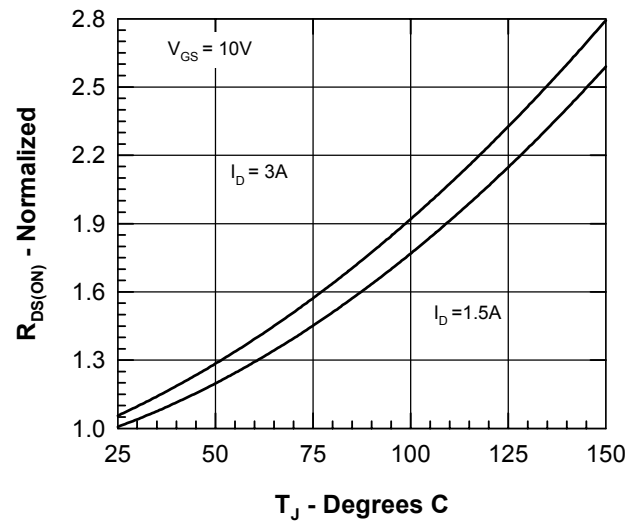


Fig. 4 Temperature Dependence of Drain to Source Resistance

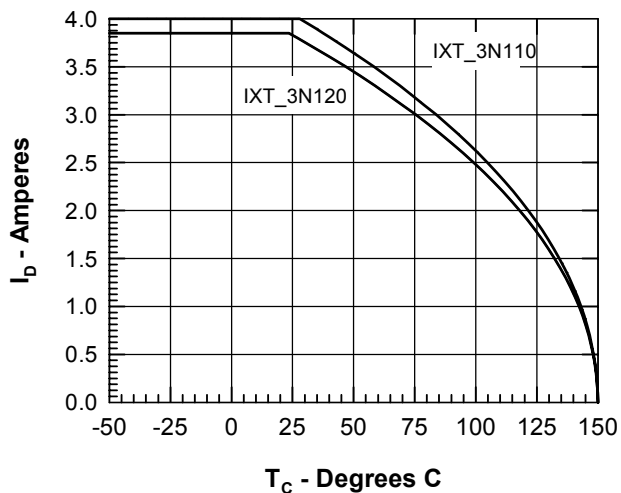


Fig. 5 Drain Current vs. Case Temperature

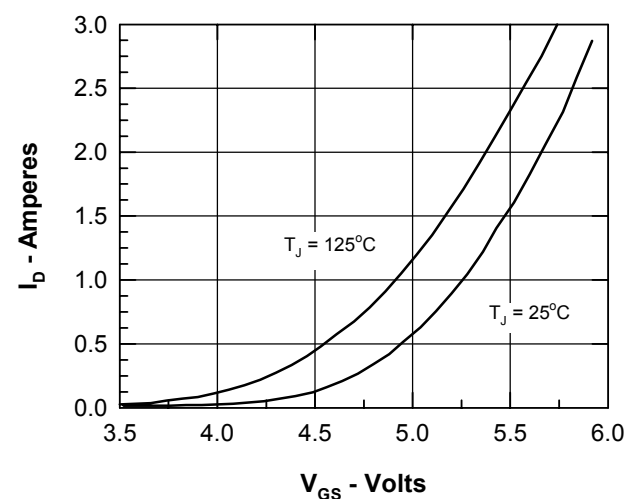


Fig. 6 Admittance Curves

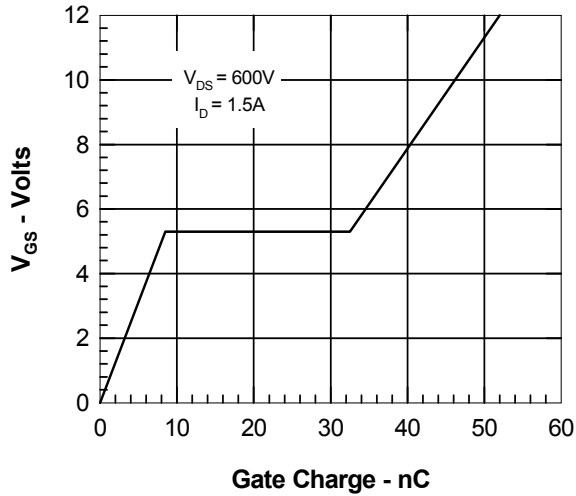


Fig. 7 Gate Charge Characteristic Curve

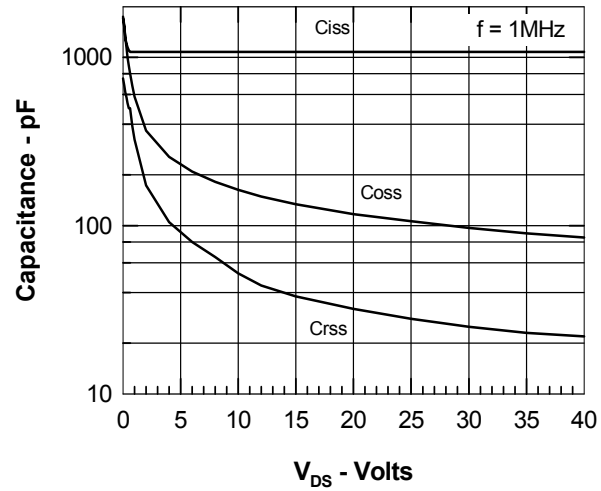


Fig. 8 Capacitance Curves

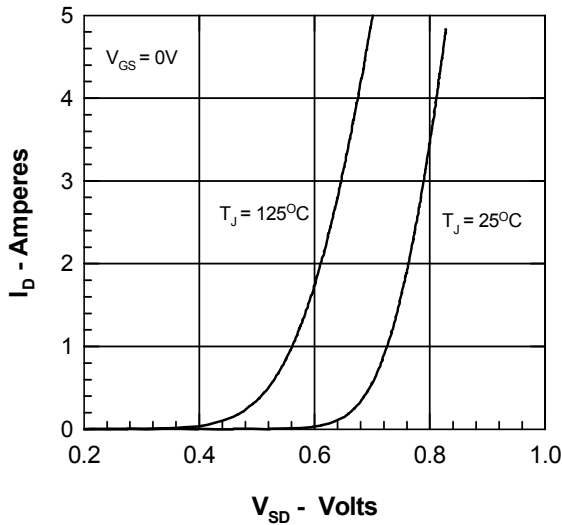


Fig. 9 Drain Current vs Drain to Source Voltage

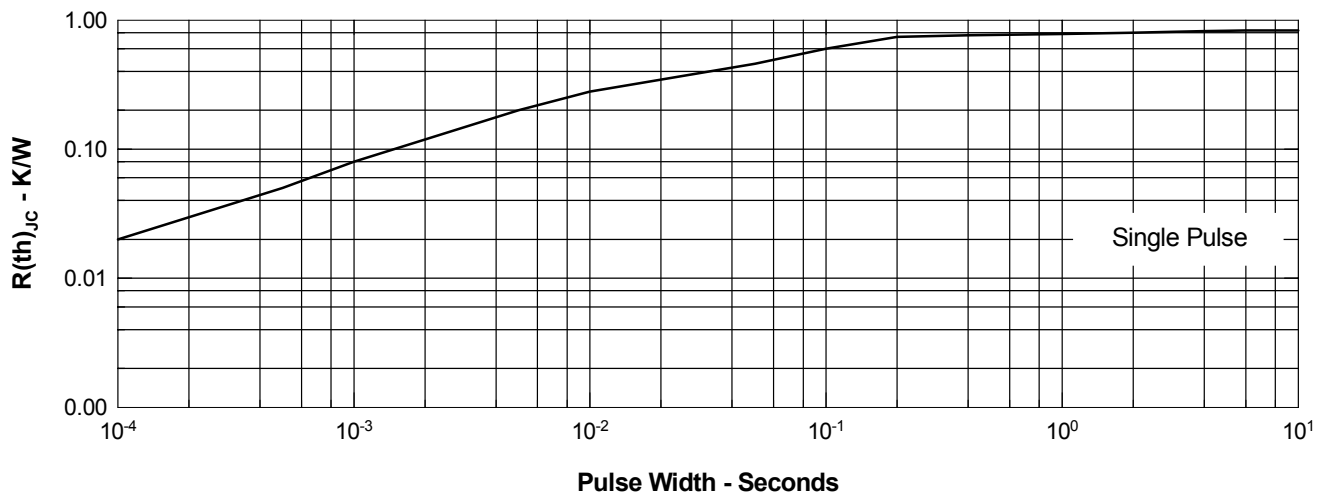


Fig. 10 Transient Thermal Impedance



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.